

(1) در مدار شکل رو بروی کسب تقویت کننده McMillan نام دارد  
 از دو تقویت کننده \$A\_1, A\_2\$ بصورت مداری استفاده شده و از  
 خروجی یکی از تقویت کننده ها به ورودی دیگری فیدبک شده است  
 هر یک از تقویت کننده های \$A\_1, A\_2\$ را بصورت Forward  
 می گویند

الف: گین کلی تقویت کننده  $A_F = \frac{x_o}{x_i}$  را بیابید.

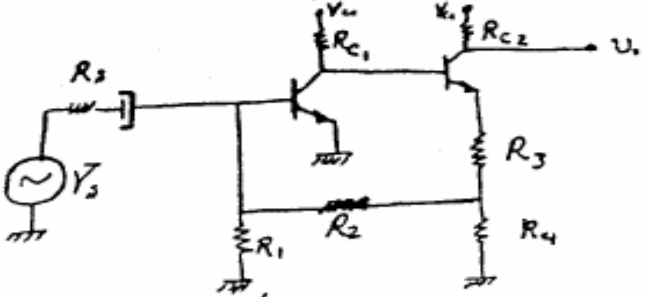
ب: برای حالتی که  $A_1 = A_2 = A$  و  $\beta_1 = \beta_2 = \beta$  باشد بدست آورید.

ج: تعیین کنید که هر طره گین حلقه هر دو تقویت کننده در حالت ب برابر یک باشد در انتیفریت

$$A_1 \beta_1 = A_2 \beta_2 = 1 \quad A_F = A$$

ت: تعیین کنید که هر طره گین حلقه یکی از تقویت کننده ها برابر یک باشد گین یکی برابر گین حلقه از  
 این تقویت کننده است تغییرات گین تقویت کننده دیگر تا تری بر گین کلی نخواهد داشت  
 حتی اگر یکی از تقویت کننده ها از مدار خارج شود (دلایل گین هر)؟ (مثلاً گین  $A_1 \beta_1 = 1$ )

(2) در مدار شکل رو بروی ترانزیستور حال از فرکانس سیلیکون با  $I_C = 1mA$  و  $V_{BE} = 0.6V$  و  $\beta_{FE} = \beta = 100$



در  $R_{ie} = 2.5k\Omega$  است معلوم است:

الف: نقاط کار ترانزیستورها؟

ب: گین ولتاژی، گین جریانی و مسامت دردی مدار؟

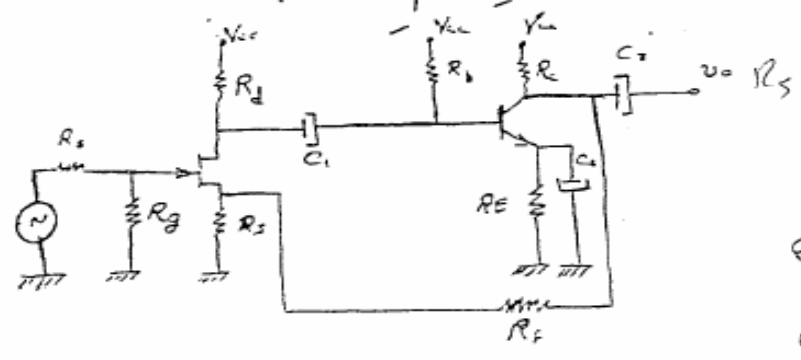
ج: اگر ترانزیستور جا را باندی دیگر که دارای  $\beta = \beta_{FE} = 150$  و  $R_{ie} = 5k\Omega$  است عوض کنیم نقاط کار

گین ولتاژی و گین جریانی و مسامت دردی جدید را حساب کنید.

$$R_{e1} = 19k\Omega \quad R_{e2} = 10k\Omega \quad R_3 = 1k\Omega \quad R_4 = 3k\Omega \quad R_1 = 25k\Omega$$

$$R_2 = 40k\Omega \quad R_5 = 1k\Omega \quad V_{CC} = 12V$$

3) در شکل زیر برای ترانزیستورهای  $Q_1$  و  $Q_2$  مشخصات زیر را درم مطلب است:

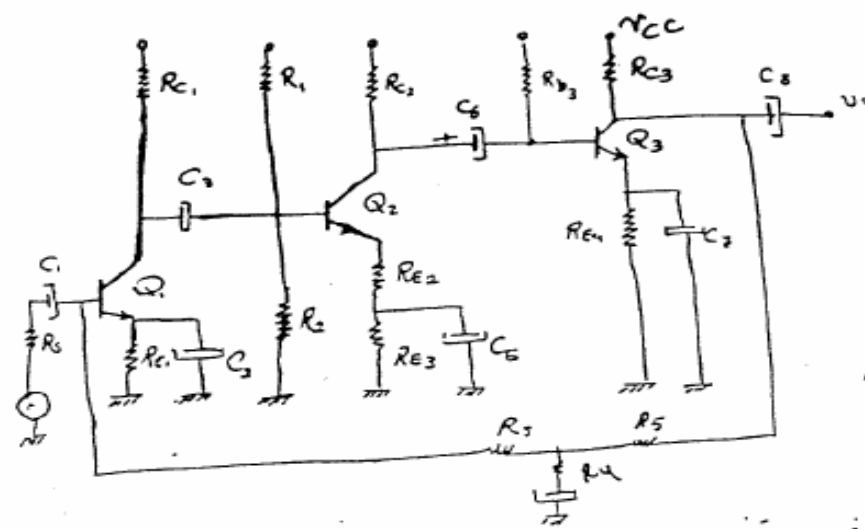


الف: نقاط کار  
ب: گین ولتاژی و ضرایب عبور سیگنال

$Q_1: I_{DSS} = 3.3 \text{ mA} \quad V_p = -4 \text{ V}$   
 $Q_2: \beta = \beta_{FE} = 100 \quad V_{BE} = 0.6 \text{ V} \quad \gamma_{VT} = 25$

$V_{CC} = 20 \text{ V} \quad R_g = 2.2 \text{ M}\Omega \quad R_D = 4.7 \text{ k}\Omega \quad R_S = 220 \Omega \quad R_B = 870 \Omega$   
 $R_C = 2.2 \text{ k}\Omega \quad R_E = 1 \text{ k}\Omega \quad R_F = 5 \text{ k}\Omega$

4) در مدار زیر مطلب است



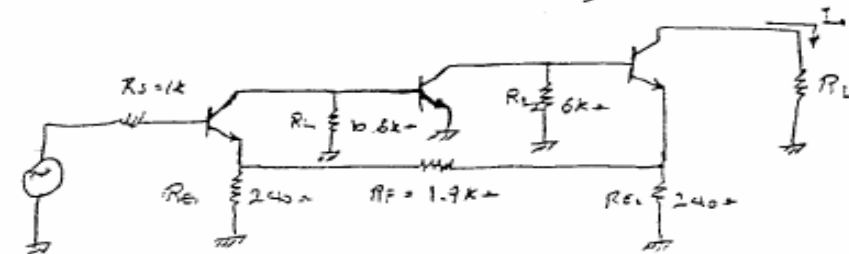
الف: نقطه کار برای هر ترانزیستور  
ب: گین ولتاژی، گین توانی و ضرایب عبور سیگنال  
ولتاژی نسبت به منبع  $(A_{V3} = \frac{V_o}{V_i})$   
ضرایب ورودی و ضرایب خروجی نسبت به کسند  
را حساب کنید

سیگنال ورودی  $12 \text{ V}$  و  $10 \text{ V}$  با ضرایب تغییرات مشخصه های حرارتی شده در قسمت ب را بدین

$V_{CC} = 12 \text{ V} \quad R_{C1} = 4.7 \text{ k}\Omega \quad R_{E1} = 8.7 \text{ k}\Omega \quad R_S = 1 \text{ k}\Omega$   
 $R_1 = 36 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 10 \text{ k}\Omega \quad R_3 = 470 \text{ k}\Omega \quad R_4 = 12 \text{ k}\Omega$   
 $R_{C2} = 2.2 \text{ k}\Omega \quad R_{E2} = 50 \Omega \quad R_{E3} = 950 \Omega \quad R_{B3} = 87 \text{ k}\Omega$   
 $R_{C3} = 470 \Omega \quad R_{E4} = 270 \Omega \quad V_{BE} = 0.6 \text{ V} \quad \gamma_{VT} = 52 \text{ mV}$   
 $Q_1, Q_2: \beta_{FE} = 20$   
 $Q_3: \beta_{FE} = 100$

5) در شکل زیر مدار معادل AC که نسبت گرفته شده است. فیدبک هم شده است. باید در نظر گرفتن مدار زیر

الف: امپدانس در خروجی، امپدانس خروجی  $A_{V}$  را برای این مدار بدین آورید.  
ب: حالت اصف را برای حالتی که در خروجی از ترانزیستور  $Q_2$  گرفته شده است برآورد کنید.



$I_{C1} = 0.5 \text{ mA}$   
 $I_{C2} = 0.77 \text{ mA}$   
 $I_{C3} = 0.73 \text{ mA}$   
 $R_L = 120 \Omega$